

CM1003-CME 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护，适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。

■ 功能特点

1) 高精度电压检测功能

• 过充电保护电压	4.655 V	精度 ±20 mV
• 过充电解除电压	4.455 V	精度 ±45 mV
• 过放电保护电压	2.700 V	精度 ±50 mV
• 过放电解除电压	2.700 V	精度 ±50 mV
• 放电过流保护电压	0.050 V	精度 ±5 mV
• 短路保护电压	0.097 V	精度 ±30 mV
• 充电过流保护电压	-0.060 V	精度 ±5 mV

2) 内部检测延迟时间

• 过充电保护延时	1.0 s	精度 ±30%
• 过放电保护延时	128 ms	精度 ±30%
• 放电过流保护延时	32 ms	精度 ±30%
• 充电过流保护延时	32 ms	精度 ±30%

3) 充电器检测及负载检测功能

4) 可选择向 0V 电池充电功能	禁止
5) 可选择休眠功能	有
6) 可选择放电过流状态的解除条件	断开负载
7) 可选择放电过流状态的解除电压	V _{RIOV}

8) 低电流消耗

• 工作时	1.5 μA (典型值) (Ta = +25°C)
• 休眠时	50 nA (最大值) (Ta = +25°C)

9) RoHS、无铅、无卤素

■ 应用领域

- 单节锂离子/锂聚合物可充电电池

■ 封装

- DFN1.2×1.2-6L

■ 系统功能框图

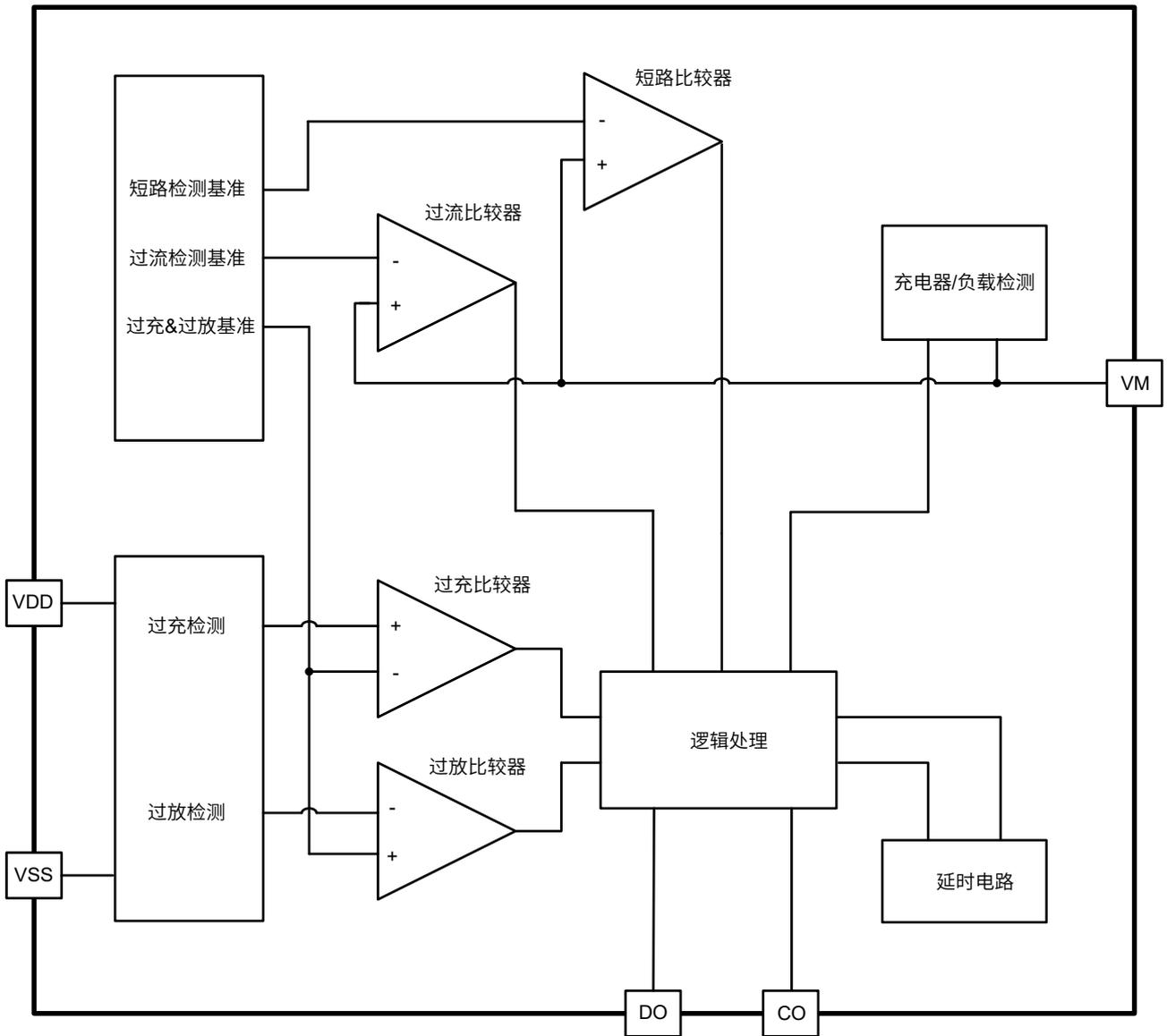
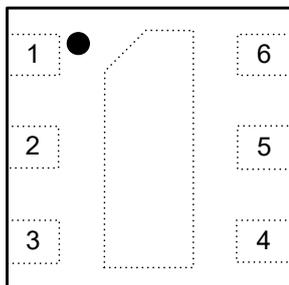
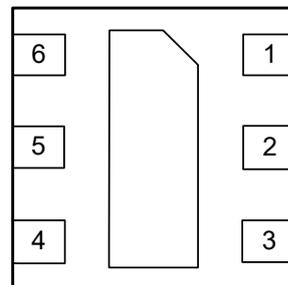


图 1

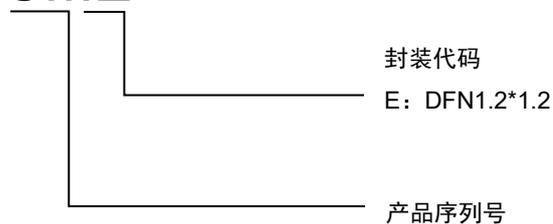
■ 引脚排列图
DFN1.2×1.2-6L

图 2 顶视图

图 3 底视图

引脚号	符号	描述
1	NC	无连接
2	CO	充电 MOSFET 控制端子
3	DO	放电 MOSFET 控制端子
4	VSS	电源接地端，与供电电源(电池)的负极相连
5	VDD	电源输入端，与供电电源(电池)的正极连接
6	VM	充放电电流检测端子，与充电器或负载的负极连接

表 1

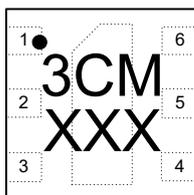
■ 命名规则

CM1003-CME



■ 印字说明

DFN1.2×1.2-6L



第一行：3 为产品系列代码，CM 为产品序列号
第二行：生产批次

图 4

■ 产品列表
DFN1.2×1.2-6L 封装产品
1. 检测电压表

产品名称	过充电 保护电压 V_{OC}	过充电 解除电压 V_{OCR}	过放电 保护电压 V_{OD}	过放电 解除电压 V_{ODR}	放电过流 保护电压 V_{EC}	短路 保护电压 V_{SHORT}	充电过流 保护电压 V_{CHA}
CM1003-CME	4.655 V	4.455 V	2.700 V	2.700 V	0.050 V	0.097 V	-0.060 V

表 2

2. 产品功能表

产品名称	向 0V 电池 充电功能	放电过流状态 解除条件	放电过流状态 解除电压	过充自恢复 功能	休眠功能	延迟时间 代码
CM1003-CME	禁止	断开负载	V_{RIOV}	有	有	M

表 3

3. 延迟时间代码

延迟时间代码	过充电保护延时 T_{OC}	过放电保护延时 T_{OD}	放电过流延时 T_{EC}	充电过流延时 T_{CHA}	短路延时 T_{SHORT}
M	1000 ms	128 ms	32 ms	32 ms	280 μ s

表 4

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VDD 和 VSS 之间输入电压	VDD	VSS-0.3 ~ VSS+8.0	V
VM 输入端子电压	V _{VM}	VDD-28 ~ VDD+0.3	V
CO 输出端子电压	V _{CO}	V _{VM} -0.3 ~ VDD+0.3	V
DO 输出端子电压	V _{DO}	VSS-0.3 ~ VDD+0.3	V
工作温度范围	T _{OPR}	-40 ~ +85	°C
储存温度范围	T _{STG}	-55 ~ +125	°C

表 5

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外: Ta = +25°C)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I _{OPe}	VDD=3.5V, V _{VM} =0V	0.9	1.5	3.0	μA
休眠电流	I _{PDN}	VDD=V _{VM} =1.2V	-	-	50	nA
[检测电压]						
过充电保护电压	V _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	4.635	4.655	4.675	V
过充电解除电压	V _{OCR}	VDD=4.8 → 3.5V	4.410	4.455	4.500	V
过放电保护电压	V _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	2.650	2.700	2.750	V
过放电解除电压	V _{ODR}	VDD=2.0 → 3.5V	2.650	2.700	2.750	V
放电过流保护电压	V _{EC}	VM-VSS=0 → 0.30V	0.045	0.050	0.055	V
短路保护电压	V _{SHORT}	VM-VSS=0 → 1.5V	0.067	0.097	0.127	V
充电过流保护电压	V _{CHA}	VSS-VM=0 → 0.30V	-0.065	-0.060	-0.055	V
放电过流解除电压	V _{RIOV}	-	VDD-1.4	VDD-1.0	VDD-0.6	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	700	1000	1300	ms
过放电保护延时	T _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	89.6	128	166.4	ms
放电过流保护延时	T _{EC}	VM-VSS=0 → V _{EC} +0.1V	22.4	32	41.6	ms
充电过流保护延时	T _{CHA}	VSS-VM=0 → 0.30V	22.4	32	41.6	ms
短路保护延时	T _{SHORT}	VM-VSS=0 → 1.5V	140	280	504	μs
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R _{VMC}	VDD=1.8V, V _{VM} =0V	750	1500	3000	kΩ
VM 端子-VSS 端子间电阻	R _{VMS}	VDD=3.5V, V _{VM} =1.0V	10	20	30	kΩ
[输出电阻]						
CO 端子电阻 “H”	R _{COH}	-	5	10	20	kΩ
CO 端子电阻 “L”	R _{COL}	-	5	10	20	kΩ
DO 端子电阻 “H”	R _{DOH}	-	5	10	20	kΩ
DO 端子电阻 “L”	R _{DOL}	-	5	10	20	kΩ
[向 0V 电池充电的功能]						
禁止向 0V 电池充电的 电池电压	V _{0INH}	禁止向 0V 电池充电功能	0.9	1.2	1.5	V

表 6

■ 电气特性

(除特殊注明以外: Ta = -20°C ~ +60°C*1)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
[功耗]						
正常工作电流	I _{OP}	VDD=3.5V, V _{VM} =0V	0.6	1.5	5.0	μA
休眠电流	I _{PDN}	VDD=V _{VM} =1.2V	-	-	150	nA
[检测电压]						
过充电保护电压	V _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	4.615	4.655	4.695	V
过充电解除电压	V _{OCR}	VDD=4.8 → 3.5V	4.380	4.455	4.530	V
过放电保护电压	V _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	2.620	2.700	2.780	V
过放电解除电压	V _{ODR}	VDD=2.0 → 3.5V	2.620	2.700	2.780	V
放电过流保护电压	V _{EC}	VM-VSS=0 → 0.30V	0.040	0.050	0.060	V
短路保护电压	V _{SHORT}	VM-VSS=0 → 1.5V	0.057	0.097	0.137	V
充电过流保护电压	V _{CHA}	VSS-VM=0 → 0.30V	-0.070	-0.060	-0.050	V
放电过流解除电压	V _{RIOV}	-	VDD-1.6	VDD-1.0	VDD-0.4	V
[延迟时间]						
过充电保护延时	T _{OC}	VDD=3.5 → 4.8V	500	1000	2000	ms
过放电保护延时	T _{OD}	VDD=3.5 → 2.0V	64	128	256	ms
放电过流保护延时	T _{EC}	VM-VSS=0 → V _{EC} +0.1V	16	32	64	ms
充电过流保护延时	T _{CHA}	VSS-VM=0 → 0.30V	16	32	64	ms
短路保护延时	T _{SHORT}	VM-VSS=0 → 1.5V	112	280	616	μs
[内部电阻]						
VDD 端子-VM 端子间电阻	R _{VMC}	VDD=1.8V, V _{VM} =0V	500	1500	6000	kΩ
VM 端子-VSS 端子间电阻	R _{VMS}	VDD=3.5V, V _{VM} =1.0V	7.5	20	40	kΩ
[输出电阻]						
CO 端子电阻 “H”	R _{COH}	-	2.5	10	30	kΩ
CO 端子电阻 “L”	R _{COL}	-	2.5	10	30	kΩ
DO 端子电阻 “H”	R _{DOH}	-	2.5	10	30	kΩ
DO 端子电阻 “L”	R _{DOL}	-	2.5	10	30	kΩ
[向 0V 电池充电的功能]						
禁止向 0V 电池充电的 电池电压	V _{0INH}	禁止向 0V 电池充电功能	0.6	1.2	1.8	V

表 7

*1.并没有在高温以及低温的条件下进行筛选, 因此只保证在此温度范围下的设计规格。

■ 功能描述

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压 (V_{OD}) 以上并在过充电保护电压 (V_{OC}) 以下，且VM端子电压在充电过流保护电压 (V_{CHA}) 以上并在放电过流保护电压 (V_{EC}) 以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，即可恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压 (V_{OC})，并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间 (T_{OC}) 时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

- 1) $VM < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充电解除电压 (V_{OCR}) 以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 2) 移开充电器并连接负载 ($VM > V_{EC}$)，当电池电压降低到过充电保护电压 (V_{OC}) 以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，降低到过放电保护电压 (V_{OD}) 以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间 (T_{OD}) 时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

在过放电状态下，如果VDD端子—VM端子间的电压差降低到1.0V (典型值)以下，消耗电流将减少至休眠时的消耗电流 (I_{PDN})，这个状态称为“休眠状态”。不连接充电器，VM端子电压 $\geq 0.7V$ (典型值) 的情况下，即使电池电压在 V_{ODR} 以上也维持过放电状态。过放电状态在以下两种情况下可以解除：

- 1) 连接充电器，若 $VM \leq 0V$ (典型值)，当电池电压高于过放电保护电压 (V_{OD}) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $0V$ (典型值) $< VM < 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放电解除电压 (V_{ODR}) 时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压 (V_{EC})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间 (T_{EC})，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压 (V_{SHORT})，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间 (T_{SHORT})，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{RIOV} ”。

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间通过 R_{VMS} 电阻来连接。在连接负载期间，VM端子由于负载连接而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 V_{RIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流状态

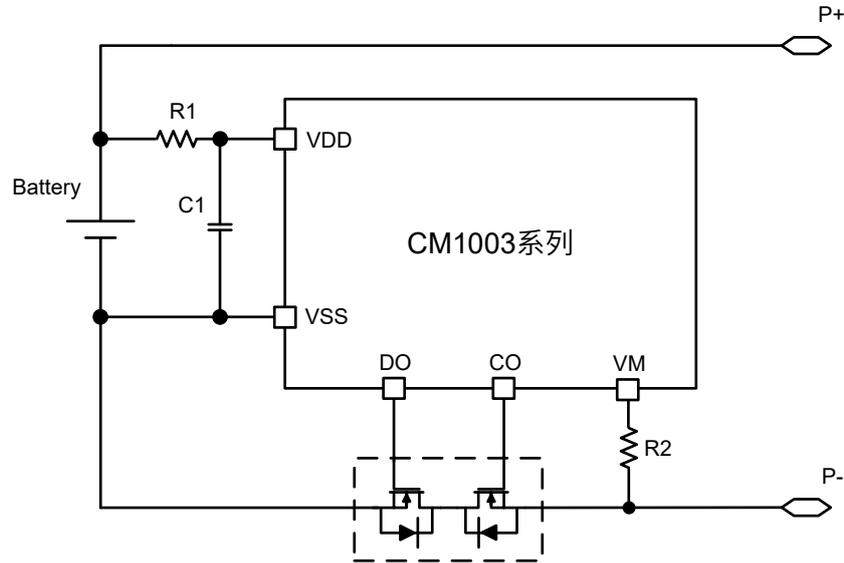
正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ V_{CHA} ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ T_{CHA} ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

注意：充电过流的解除电压为0V(典型值)，若使充电过电流可靠解除，VM端子电压需 $\geq 0.01V$ ，而实际发生充电过流保护状态后，如果断开充电器或接入负载，VM端子由 R_{VMC} 或负载上拉，由于充电MOSFET体二极管存在，VM端子电压一定高于0.01V，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向 0V 电池充电功能（禁止）

当连接内部短路的电池（0V电池）时，禁止向0V电池充电的功能会阻止对它再充电。当电池电压低于“禁止向0V电池充电的电池电压（ V_{0INH} ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为P-电压，禁止充电。当电池电压高于“禁止向0V电池充电的电池电压（ V_{0INH} ）”时，可以充电。

注意：请咨询电池厂商，被完全放电后的电池，是否推荐再一次进行充电，以决定允许或禁止向0V电池充电。

■ 典型应用原理图

图 5

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	470	470 ~ 1500	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 0.220	μF
R2	2	1 ~ 3	$\text{k}\Omega$

表 8
注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

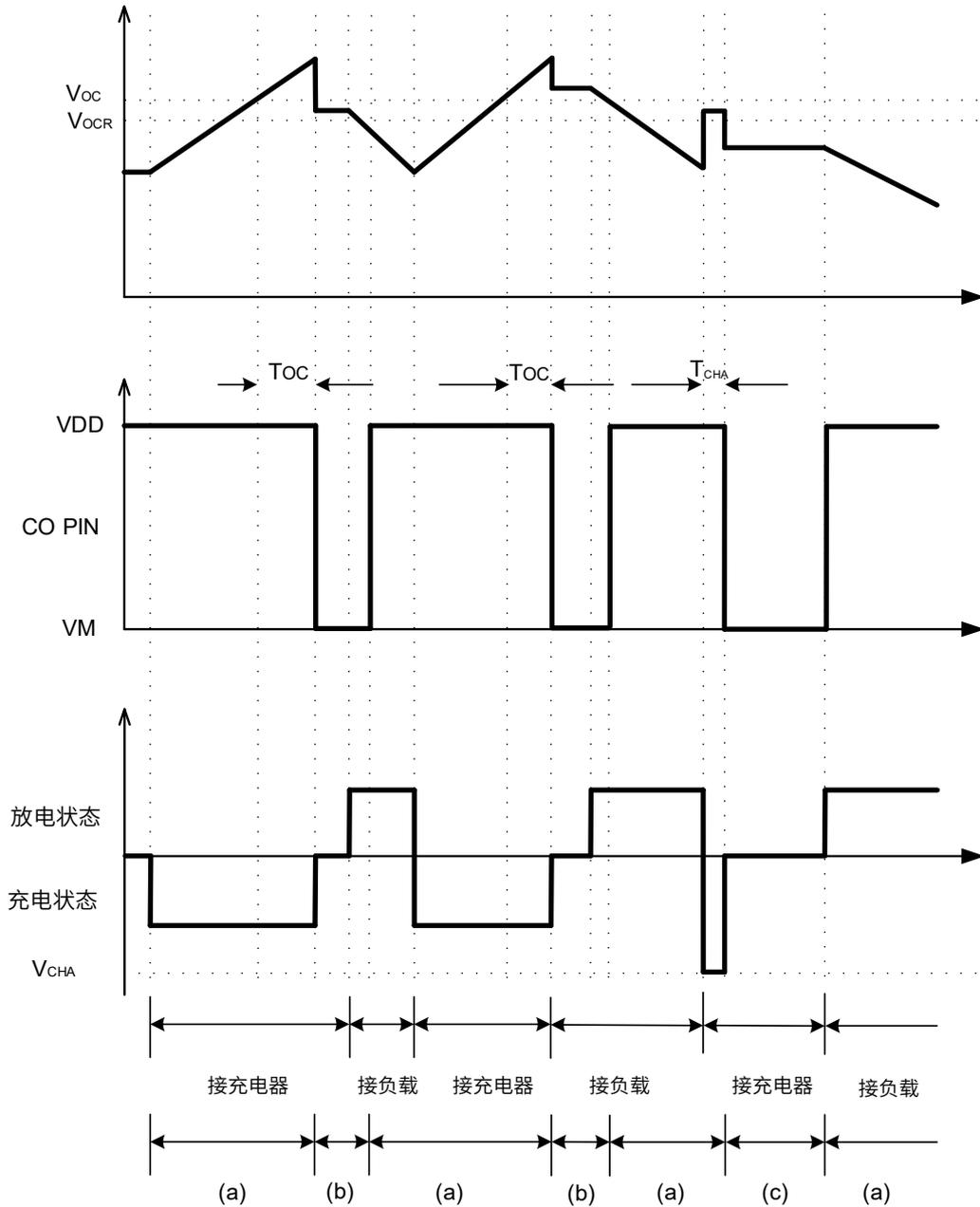


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

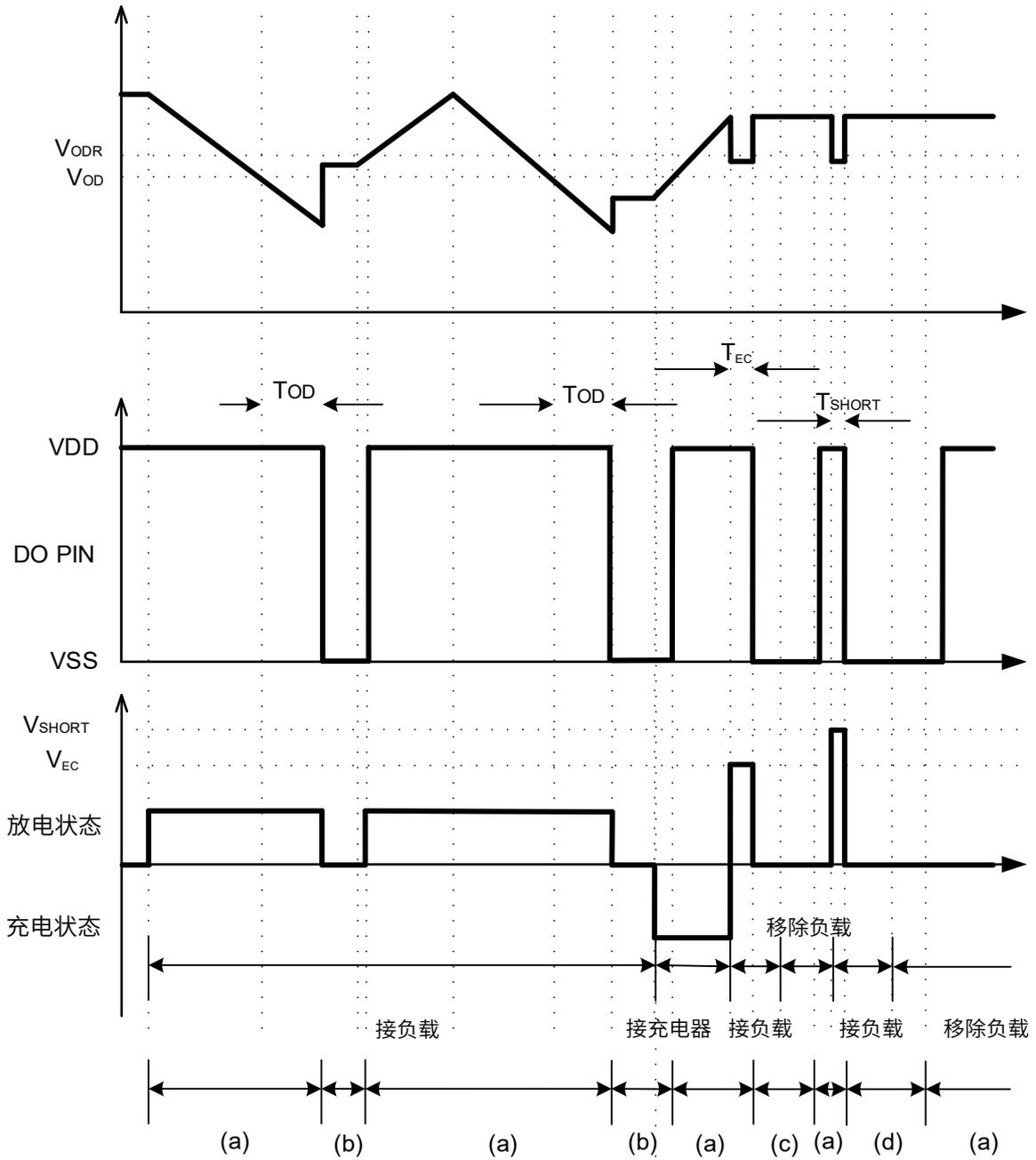


图 7

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

■ 测试电路

1. 过充电保护电压、过充电解除电压（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V1$ 缓慢提升至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$ 时的 $V1$ 的电压即为过充电保护电压 (V_{OC})。之后, 设置 $V2=0.01V$, 将 $V1$ 缓慢下降至 $V_{CO} = "L" \rightarrow "H"$ 时的 $V1$ 的电压即为过充电解除电压 (V_{OCR})。

2. 过放电保护电压、过放电解除电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V1$ 缓慢降低至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ 时的 $V1$ 的电压即为过放电保护电压(V_{OD})。之后, 设置 $V2=0.01V$, 将 $V1$ 缓慢提升至 $V_{DO} = "L" \rightarrow "H"$ 时的 $V1$ 的电压即为过放电解除电压 (V_{ODR})。

3. 放电过电流保护电压、放电过电流解除电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 提升, 直至 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$ 为止, 此时的 $V2$ 电压即为放电过电流检测电压 (V_{EC})。

在放电过电流状态下, 设置 $V2=3.5V$, 将 $V2$ 缓慢降低, 直至 $V_{DO} = "L" \rightarrow$ 脉冲" H " 时(此时放电过电流状态解除后, 可能由于 $V2$ 电压高于 V_{SHORT} 而发生负载短路保护再次使 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$)的 $V2$ 电压即为放电过电流状态的解除电压 (V_{RIOV})。

4. 负载短路保护电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 瞬间提升, 经过负载短路保护延迟时间 (T_{SHORT})后立即发生 $V_{DO} = "H" \rightarrow "L"$, 此时的 $V2$ 的电压即为负载短路保护电压 (V_{SHORT})。

5. 充电过流保护电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 降低, 直至 $V_{CO} = "H" \rightarrow "L"$ 为止, 此时的 $V2$ 电压即为充电过电流保护电压 (V_{CHA})。

6. 工作时消耗电流（测试电路 3）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 流经 VDD 端子的电流 I_{CC} 即为工作时消耗电流 (I_{OPE})。

7. 休眠时消耗电流（测试电路 3）

在 $V1=V2=1.2V$ 设置后的状态下, 流经 VDD 端子的电流 I_{CC} 即为休眠时消耗电流 (I_{PDN})。

8. VDD 端子-VM 端子间电阻（测试电路 3）

在 $V1=1.8V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, VDD 端子- VM 端子间电阻即为 R_{VMC} 。

9. VM 端子-VSS 端子间电阻（测试电路 3）

在 $V1=3.5V$, $V2=1.0V$ 设置后的状态下, VM 端子- VSS 端子间电阻即为 R_{VMS} 。

10. CO 端子电阻“H”（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$, $V3=3.1V$ 设置后的状态下, VDD 端子- CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 "H" (R_{COH})。

11. CO 端子电阻“L”（测试电路 4）

在 $V1=4.7V$, $V2=0V$, $V3=0.4V$ 设置后的状态下, VM 端子- CO 端子间电阻即为 CO 端子电阻 "L" (R_{COL})。

12. DO 端子电阻“H”（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$, $V4=3.1V$ 设置后的状态下, VDD 端子- DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 "H" (R_{DOH})。

13. DO 端子电阻 “L” (测试电路 4)

在 $V1=1.8V$, $V2=0V$, $V4=0.4V$ 设置后的状态下, VSS 端子-DO 端子间电阻即为 DO 端子电阻 “L” (R_{DOL})。

14. 过充电保护延迟时间 (测试电路 5)

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V1$ 提升, 从 $V1$ 超过 V_{OC} 时开始到 $V_{CO} = "L"$ 为止的时间即为过充电保护延迟时间 (T_{OC})。

15. 过放电保护延迟时间 (测试电路 5)

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V1$ 降低, 从 $V1$ 低于 V_{OD} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为过放电保护延迟时间 (T_{OD})。

16. 放电过流保护延迟时间 (测试电路 5)

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 提升, 从 $V2$ 超过 V_{EC} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为放电过流保护延迟时间 (T_{EC})。

17. 负载短路保护延迟时间 (测试电路 5)

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 提升, 从 $V2$ 超过 V_{SHORT} 时开始到 $V_{DO} = "L"$ 为止的时间即为负载短路保护延迟时间 (T_{SHORT})。

18. 充电过流保护延迟时间 (测试电路 5)

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下, 将 $V2$ 降低, 从 $V2$ 低于 V_{CHA} 时开始到 $V_{CO} = "L"$ 为止的时间即为充电过流保护延迟时间 (T_{CHA})。

19. 禁止向 0V 电池充电的电池电压 (“禁止”向 0V 电池充电的功能) (测试电路 2)

在 $V1=1.9V$, $V2= -1.0V$ 设置后的状态下, 将 $V1$ 缓慢降低, 当 $V_{CO} = "L"$ ($V_{CO} = V_{VM}$) 时的 $V1$ 的电压即为禁止向 0V 电池充电的电池电压 (V_{0INH})。

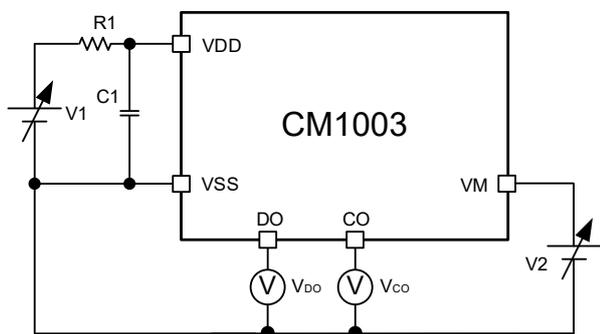


图 8 测试电路 1

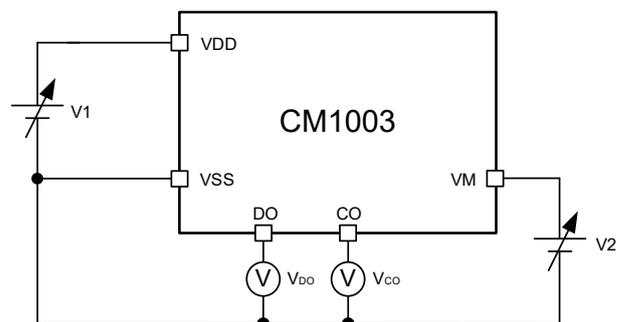


图 9 测试电路 2

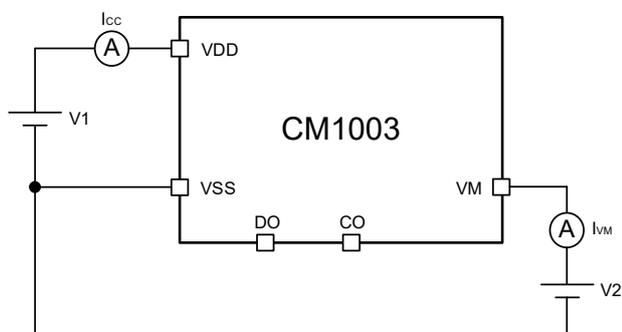


图 10 测试电路 3

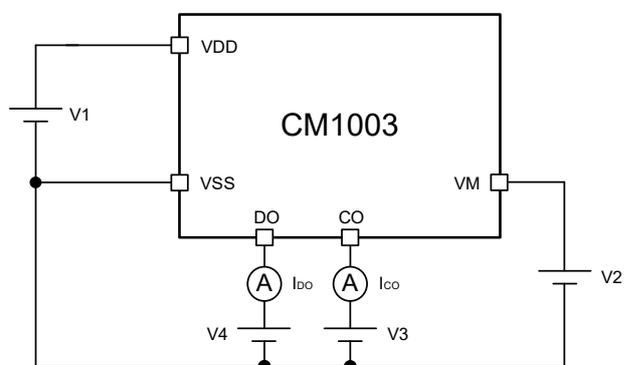


图 11 测试电路 4

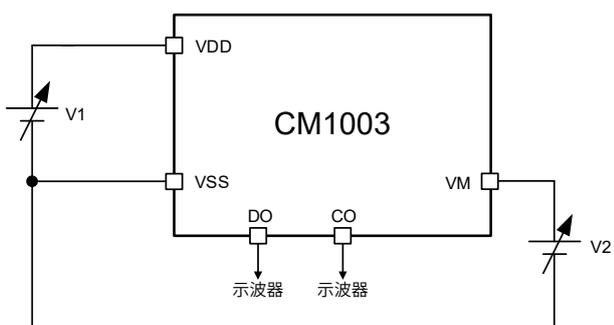
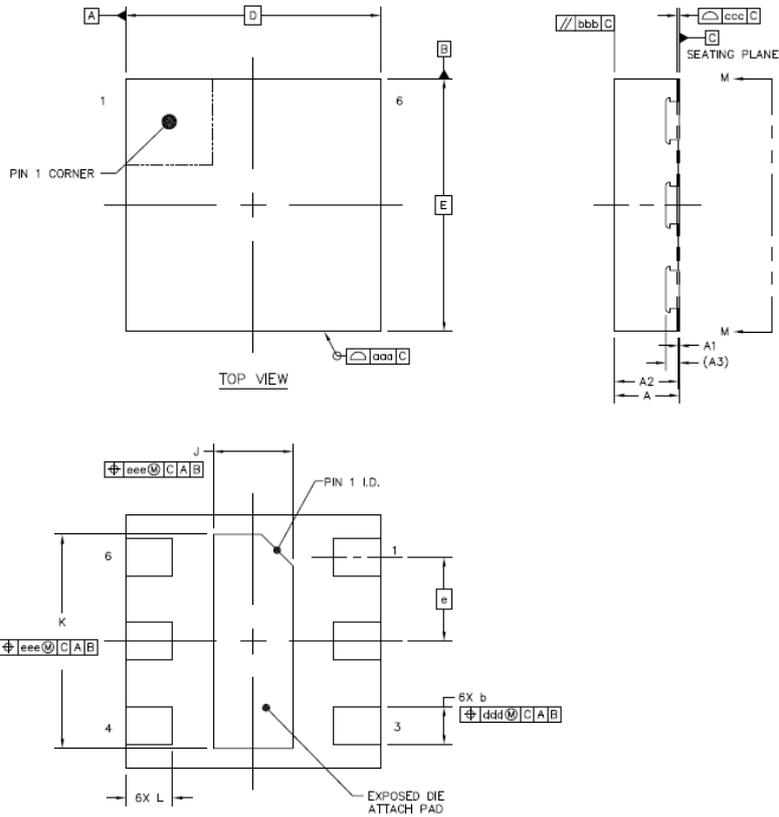


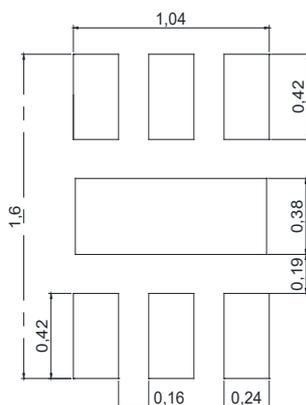
图 12 测试电路 5

■ 封装信息
DFN1.2x1.2-6L

图 13

NOTE: ALL DIMENSIONS IN MM

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.28	0.3	0.34
A1	0	0.005	0.01
A2	---	0.3	---
A3	0.06 REF		
b	0.13	0.18	0.23
D	1.1	1.2	1.3
E	1.1	1.2	1.3
e	0.4 BSC		
J	0.35	0.375	0.4
K	0.99	1.015	1.04
L	0.17	0.22	0.27

表 9

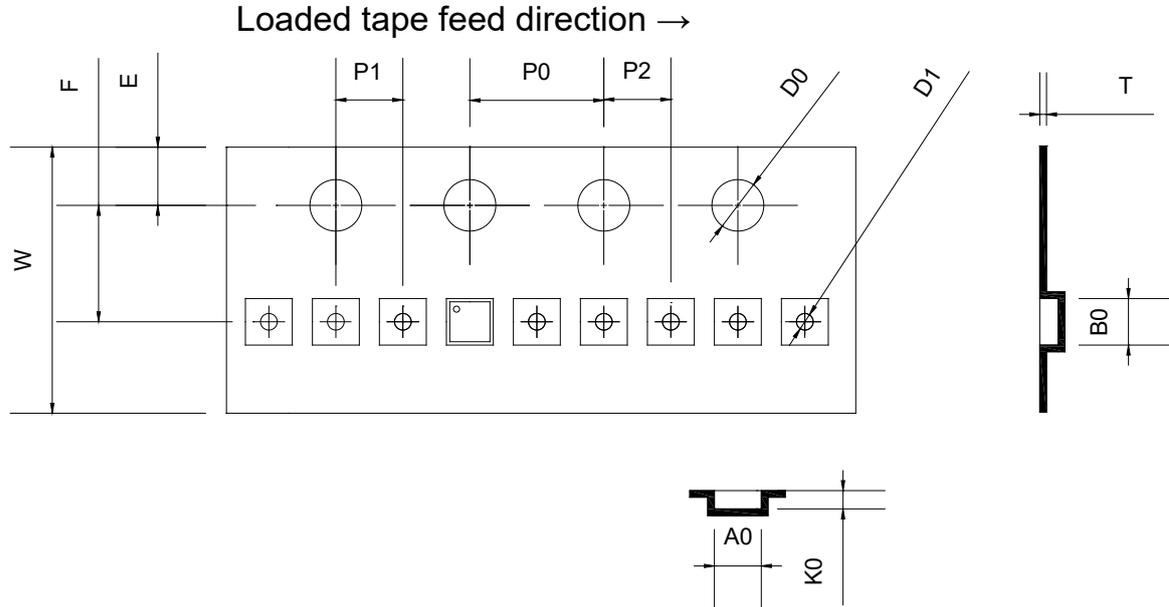
■ PCB 尺寸推荐
DFN1.2x1.2-6L

图 14

注意：1.请勿在塑封体下印刷丝网、焊锡，避免产品被顶起。

2.钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘对齐。

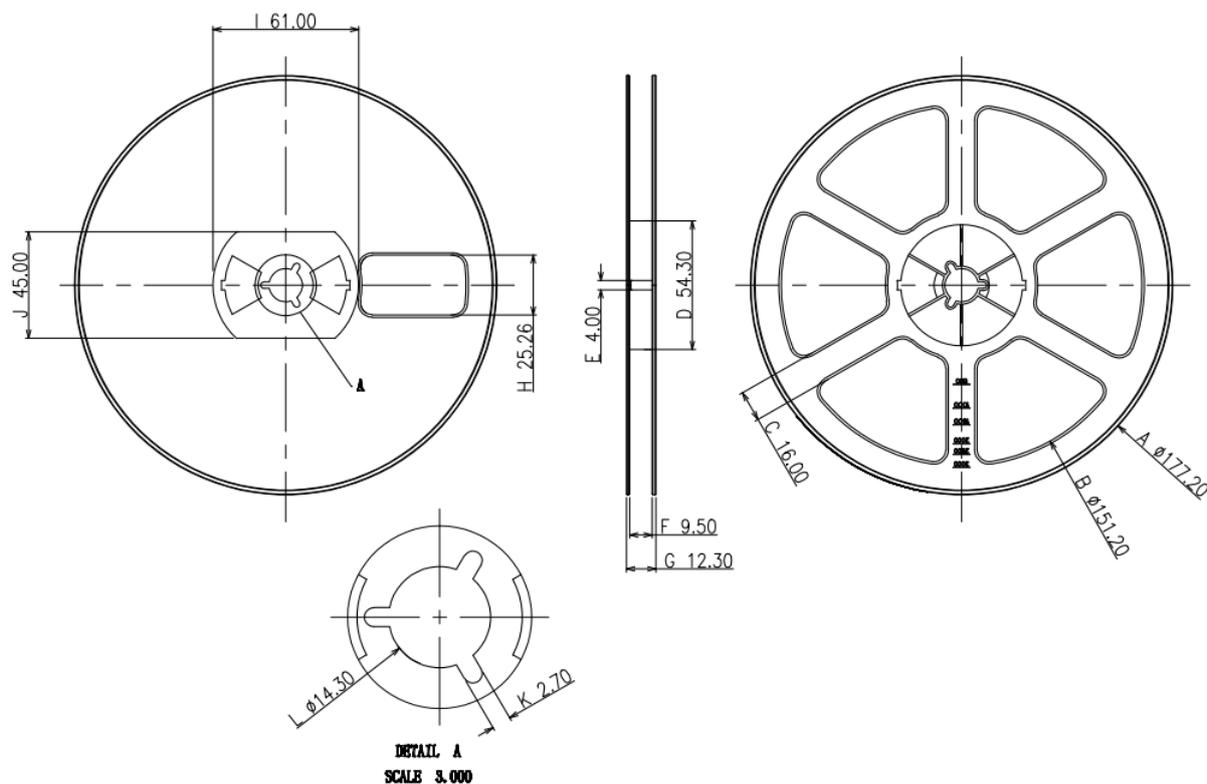
3.请向引脚的前端方向扩展焊盘模式。

4.请勿向封装中间的范围扩大焊盘模式。

■ 载带信息
DFN1.2x1.2-6L

图 15

Type	W*P1	Unit
DFN1.2*1.2	8.0*2.0	mm
Item	Specification	Tol (+/-)
W	8.00	±0.20
F	3.50	±0.05
E	1.75	±0.10
P2	2.00	±0.10
P1	2.00	±0.10
P0	4.00	±0.10
P0*10	40.00	±0.20
D0	1.55	±0.05
D1	0.50	±0.10
T	0.22	±0.07
B0	1.38	±0.08
A0	1.38	±0.08
K0	0.53	±0.08

表 10

■ 卷盘信息

图 16
■ 包装信息

卷盘	颗/盘	盘/盒	盒/箱
7" 盘	10000 PCS	10	4

使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。